|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Значение |
| Площадь кремниевой мишени (м2) | 0.004 |
| Площадь молибденовой мишени (м2) | 0.004 |
| Подверженная воздействию потока частиц площадь поверхности камеры Si и Si3N4 (м2) | 0.3 |
| Подверженная воздействию потока частиц площадь поверхности камеры Mo и MoN (м2) | 0.3 |
| Коэффициент распыления Si для E(Ar+) = 400 эВ | 0.9 |
| Коэффициент распыления SiN для E(Ar+) = 400 эВ | 0.3 |
| Коэффициент распыления Mo для E(Ar+) = 400 эВ | 0.9 |
| Коэффициент распыления MoN для E(Ar+) = 400 эВ | 0.3 |
| Скорость откачки (л/с) | 1200 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на поверхности Si **в области плазмы** | 0.1 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на **прореагировавшей** поверхности Si3N4 **в области плазмы** | 0.00001 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на поверхности Si **вне области плазмы** | 0.005 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на **прореагировавшей** поверхности Si3N4 **вне области плазмы** | 0.005 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на поверхности Mo **в области плазмы** | 0.6 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на **прореагировавшей** поверхности MoN **в области плазмы** | 0.01 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на поверхности Mo **вне области плазмы** | 0.1 |
| Коэффициент задерживания молекулы **азота** на **прореагировавшей** поверхности MoN **вне области плазмы** | 0.01 |
| Коэффициент задерживания молекулы O2 на поверхности Si | 0.6 |
| Коэффициент задерживания молекулы O2 на  **прореагировавшей** поверхности Si3N4 | 0.03 |
| Коэффициент задерживания молекулы O2 на поверхности Mo | 0.5 |
| Коэффициент задерживания молекулы O2 на  **прореагировавшей** поверхности MoN | 0.03 |
| Температура (К) | 273 |